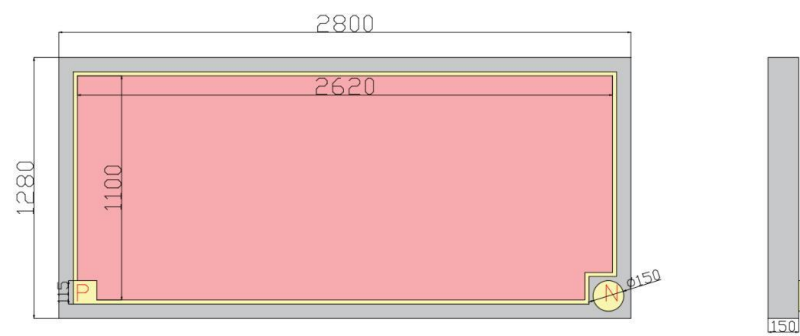


Кремниевый PIN фотодетекторный чип 2.8×1.28 мм — техническое описание

P/N : WS9G-01C

Применение
Si PIN фотодиодный чип

Структура
Планарная структура: PIN-диод;
электроды: верхняя сторона (катод) — Al,
верхняя сторона (анод) — Al



ГАБАРИТЫ

Габариты	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Активная область	2620 x 1100±15			мкм
Ширина чипа	1280			мкм
Длина чипа	2800			мкм
Высота чипа	125	150	175	мкм
Контактная площадка катода		150		мкм
Контактная площадка анода		115		мкм

Электрооптические характеристики (при Ta=25 °C)

Параметр	Обозначение	Условия измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Прямое напряжение	Vf	If=10mA, H =0	0.5		1.3	В
Обратное напряжение	V br	Ir =100μA, H =0	35			В
Обратный темновой ток	Id	Vr =10V			10	нА
Рабочий диапазон длин волн	λp		400	940	1100	нм
Емкость	Cj	VR =3V, f=1MHz		20		пФ